中山大学本科生期末考试

考试科目:《大学物理》(A卷)

学年学期: 2019-2020 学年第 2 学期 姓

学 院/系: 物理学院

考试方式: 闭卷 年级专业:

考试时长: 120 分钟

《中山大学授予学士学位工作细则》第八条:"考试作弊者.不授

以下为试题区域,共25道大题,总分100分,考生请在答题纸上作答

- 一、单选题(共20小题,每小题2分,共40分)
 - 1. (2 分) 两个点电荷 Q_1 和 Q_2 固定在一条直线上,相距为 d ,把第三个点电荷 Q_3 放 在 Q_1, Q_2 的延长线上, 与 Q_2 相距为 d , 如若系统能使 Q_3 保持静止, 则 C

A.
$$Q_1 = 2Q_2$$

B.
$$Q_1 = -\sqrt{2}Q_2$$

C.
$$Q_1 = -4Q_2$$

A.
$$Q_1 = 2Q_2$$
 B. $Q_1 = -\sqrt{2}Q_2$ C. $Q_1 = -4Q_2$ D. $Q_1 = -2\sqrt{2}Q_2$

2. $(2 \, \beta)$ 半径为 R 的均匀带电球面,总电荷为 Q,设无穷远处的电势为零,则球内距 离球心为 r(r < R) 的 P 点出的电场强度的大小与电势为 DA. E = 0, $U = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r}$ B. $E = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2}$, $U = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r}$

A.
$$E = 0, U = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r}$$

B.
$$E = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2}, U = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r}$$

C.
$$E = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2}, U = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R}$$

D.
$$E = 0, U = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R}$$

解析 由高斯定理很容易求得均匀带电球面的电场分布:

$$\oint_{S} \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{q}{\epsilon_{0}}$$

$$E_{1} \cdot 4\pi r^{2} = 0, E_{1} = 0, r < R$$

$$E_{2} \cdot 4\pi r^{2} = \frac{Q}{\epsilon_{0}}, E_{2} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_{0}r^{2}}, r > R$$

所以球内的电势分布为

$$U_1 = \int_r^\infty \vec{E} \cdot \mathrm{d}\vec{r} = \int_r^R E_1 \; \mathrm{d}r + \int_R^\infty E_2 \; \mathrm{d}r = 0 + \int_R^\infty \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2} \; \mathrm{d}r = -\left[\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r}\right]_R^\infty = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 R}$$

- 3. (2 分) 下列说法正确的是 A
 - A. 场强的方向总是从电势高处指向电势低处
 - B. 等势面上各个点场强的大小一定相等
 - C. 在电势高处, 电势能也一定大
 - D. 电场强度大的地方, 电势一定高

解析 略

4. (2 分) 如图1所示,在带电量为 -Q 的点电荷 A 的静电场中,将另一个带电量为 q 的试探电荷从 a 点移到 b 点,a, b 两点距离点电荷 A 的距离分别为 r_1 和 r_2 ,则移 动过程中电场力做的功为 C

A.
$$-\frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2} \right)$$
C.
$$-\frac{qQ}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2} \right)$$

B.
$$\frac{qQ}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2} \right)$$
D.
$$-\frac{qQ}{4\pi\epsilon_0(r_2 - r_1)}$$

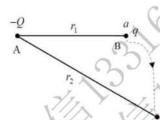


图 1 第四颗

解析 电场力做功等于电荷电势能的减少。静电场力为保守力,静电场力做功只与始末位置有关,与中间具体路径无关。

以无穷远为零电势点时, 点电荷所激发的电场的电势为

$$V = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r}$$

所以电荷为-Q的点电荷A在a、b两点的电势分别为

$$V_a = \frac{-Q}{4\pi\varepsilon_0 r_1}$$

$$V_b = \frac{-Q}{4\pi\varepsilon_0 r_2}$$

所以电荷为q的点电荷B在a、b两点的电势能分别为

$$W_a = qV_a = \frac{-qQ}{4\pi\varepsilon_0 r_1}$$

$$W_b = qV_b = \frac{-qQ}{4\pi\varepsilon_0 r_2}$$

所以移动过程中电场力所做的功为

$$A = W_a - W_b = \frac{-qQ}{4\pi\epsilon_0 r_1} - \frac{-qQ}{4\pi\epsilon_0 r_2} = \frac{-qQ}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2}\right)$$

- 5. (2 分) 导体处于静电平衡状态时以下哪种说法为错误的是 D
 - A. 导体内部以及表面均无电荷定向运动
 - B. 导体是等势体, 导体表面是等势面
 - C. 导体表面的电场强度垂直于导体表面
 - D. 实心导体内部的电场变弱, 但是不为零

解析 略

6. $(2\, \beta)$ 一块面积为 S 的很大金属平板 A 带有正电荷,电量为 Q,现把另外一个面积亦为 S 的不带电金属平板放置在 A 板附近,然后在将 A 板接地,则如图2所示,最终 A, B 两板表面上的电荷面密度分别是 A

A.
$$\sigma_1 = \sigma_2 = \sigma_3 = \sigma_4 = 0$$

B.
$$\sigma_1 = \sigma_2 = \frac{Q}{2S}, \sigma_3 = -\sigma_4 = -\frac{Q}{2S}$$

C.
$$\sigma_1 = \sigma_4 = 0, -\sigma_3 = \sigma_2 = \frac{Q}{S}$$

D.
$$\sigma_1 = \sigma_4 = 0, \sigma_3 = -\sigma_4 = \frac{Q}{S}$$

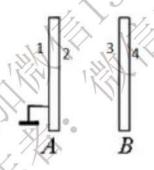


图 2 第六题

解析 静电平衡时,设从左到右四个面的电荷面密度分别为 σ_1 、 σ_2 、 σ_3 、 σ_4 ,由静电平衡时导体内电场为零可得

$$\begin{split} \frac{\sigma_1}{2\varepsilon_0} - \frac{\sigma_2}{2\varepsilon_0} - \frac{\sigma_3}{2\varepsilon_0} - \frac{\sigma_4}{2\varepsilon_0} &= 0 \Rightarrow \sigma_1 - \sigma_2 - \sigma_3 - \sigma_4 = 0 \\ \frac{\sigma_1}{2\varepsilon_0} + \frac{\sigma_2}{2\varepsilon_0} + \frac{\sigma_3}{2\varepsilon_0} - \frac{\sigma_4}{2\varepsilon_0} &= 0 \Rightarrow \sigma_1 + \sigma_2 + \sigma_3 - \sigma_4 = 0 \\ \sigma_2 + \sigma_3 &= 0, \sigma_1 - \sigma_4 = 0 \end{split}$$

又因为 B 板不带电, A 板接地, 所以有

$$\sigma_1 = 0, \sigma_3 = -\sigma_4$$

$$\sigma_4 = \sigma_1 = \sigma_2 = \sigma_3 = 0$$

7. (2 分) 真空中有一个半径为 R 的孤立金属导体球,当球上带电量为 Q 时,该体系 具有的静电场能量为 C

A.
$$4\pi\epsilon_0 RQ^2$$

B.
$$\frac{Q^2}{4\pi\epsilon_0 R}$$

C.
$$\frac{Q^2}{8\pi\epsilon_0 R}$$

D.
$$\frac{Q^2}{16\pi\epsilon_0 R}$$

解析 导体球内部无电荷, 所以问题等效为均匀带电球壳的静电能问题 带电球壳的场强分布为

$$\begin{cases} E = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2} &, r \ge a \\ E = 0 &, r < a \end{cases}$$

$$\begin{split} W_e &= \int_V \frac{1}{2} \varepsilon_0 E^2 dV \\ &= \frac{1}{2} \varepsilon_0 \int_R^\infty \left(\frac{Q}{4\pi \varepsilon_0 r^2} \right)^2 4\pi r^2 dr \\ &= \frac{Q^2}{8\pi \varepsilon_0 R} \end{split}$$

- 8. (2 分) 两个空气电容器 C_1 和 C_2 串联以后接电源充满电,在电源保持连接的情况下,在 C_2 中插入一块电介质板,如图3所示,则 A
 - A. C₁ 极板上电荷增加, C₂ 极板上电荷增加
 - B. C, 极板上电荷减少, C, 极板上电荷增加
 - C. C, 极板上电荷增加, C, 极板上电荷减少
 - $D. C_1$ 极板上电荷减少, C_2 极板上电荷减少

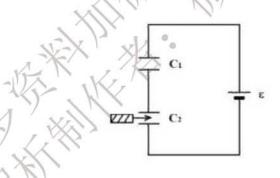


图 3 第八题

解析 回路总电容

$$C = \frac{C_1 C_2}{C_2 + C_1}$$

故插入介质后 C_2 增大,C 也增大

故 $Q_{\mathbb{R}} = CU$ 增大 (U 不变)

故 C_1 的上极板处正电荷增多, C_2 的下极板处负电荷增多

即 C_1 极板上电荷增加, C_2 极板上电荷增加

9. (2 分) 一个平行板电容器两极板的面积都是 S, 相距为 d, 其间插有一个厚度为 t(t < d) 的金属板与极板平行,且其放置面积亦是 S, 则该系统的电容大小是 B

A.
$$\frac{\epsilon_0 S}{d}$$
 B. $\frac{\epsilon_0 S}{d-t}$ C. $\frac{\epsilon_0 S}{t}$ D. $\epsilon_0 S \left(\frac{1}{t} - \frac{1}{d}\right)$ 解析 平行板电容器的电容 $C = \frac{\epsilon_0 S}{d}$

当极板间平行地挿入一块与极板面积相同的金属板,可以认为两个极板间的距离变 小, 所以电容器的电容增大。其实插入金属板, 是将一个电容变成两个电容并进行串 联,两个新电容器的极板面积不变,间距分别为 d_1 和 d_2 ,所以两个电容分别为

$$C_1 = \frac{\varepsilon_0 S}{d_1}, C_2 = \frac{\varepsilon_0 S}{d_2}$$

而由电容器串联的公式

$$\frac{1}{C_{12}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} = \frac{d_1}{\varepsilon_0 S} + \frac{d_2}{\varepsilon_0 S} = \frac{d_1 + d_2}{\varepsilon_0 S}$$

$$C_{12} = \frac{\varepsilon_0 S}{d_1 + d_2} = \frac{\varepsilon_0 S}{d - t}$$

10. (2分)如图4所示,两无穷大平行板上载有均匀分布的面电流,电流密度均为 i, 两电 流平行且同向,则 $I \cup II \cup III$ 三个区的磁感强度 B 的分布为: C

A.
$$B_1 = 0$$
; $B_2 = \frac{\mu_0 i}{2}$; $B_3 = \mu_0 i$;

A.
$$B_1 = 0$$
; $B_2 = \frac{\mu_0 i}{2}$; $B_3 = \mu_0 i$; B. $B_4 = \frac{\mu_0 i}{2}$; $B_2 = 0$; $B_3 = \frac{\mu_0 i}{2}$;

C.
$$B_1 = \mu_0 i$$
; $B_2 = 0$; $B_3 = \mu_0 i$;

D.
$$B_1 = \mu_0 i$$
; $B_2 = \mu_0 i$; $B_3 = \mu_0 i$

解析 对一个仅有期中一个无穷大平行板的情形进行分析,根据安培环路定理

$$2BL = \mu_0 I$$

$$B = \frac{\mu_0 i}{2}$$

$$B_1 = \mu_0 i; B_2 = 0; B_3 = \mu_0 i;$$

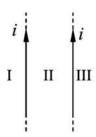


图 4 选择十

- 11. (2分)将一固定长度导线弯成一半径为 R 的单匝圆线圈, 通以电流 I, 若将该导线弯 成匝数为2的平面圆线圈,并通以同样的电流,则线圈中心的磁感应强度和线圈的 磁矩分别为单匝圆线圈的: B
 - A. 4 倍和 1/8;
- B. 4 倍和 1/2;
- C. 2 倍和 1/4; D. 2 倍和 1/2

解析

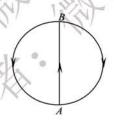
$$B = \frac{N\mu_0 I}{2R}$$

$$m = NIS$$

$$\frac{B_2}{B_1} = \frac{N_2}{N_1} \frac{R_1}{R_1} = 4$$

$$\frac{m_2}{m_1} = \frac{N_2}{N_1} \frac{R_2^2}{R_1^1} = \frac{1}{2}$$

- 12. (2分) 如图 5所示, 半径为 R 的均匀导体球壳, 内部沿球的直径方向有 线, 电流 $I \, \text{从} \, A$ 流向 B 后, 再沿球面均匀返回 A 点, 如图所示, 则下述说法中正确的 是: A
 - A. 在 AB 线上的磁感应强度 $\vec{B} = 0$;
 - B. 球外的磁感应强度 $\vec{B} = 0$;
 - C. AB 线上的磁感应强度 $\vec{B} \neq 0$;
 - D. 只有在球心上的感应强度 $\vec{B} = 0$



选择十二 图 5

- 一初速度进入均匀磁场中,若初速度v方向与磁场B方向成一 \uparrow 0 < θ < 90° 的夹角,则带电粒子将会受到磁场洛伦兹力的作用,在磁场中做 D
 - A. 变直径螺旋运动:

B. 变速圆周运动:

C. 匀速圆周运动:

D. 等距螺旋运动

解析 略

- 14. (2 分) 已知 α 粒子的质量是质子的 4 倍, 电量是质子的 2 倍, 设它们的初速度为零, 经相同的电压加速后, 垂直进入匀强磁场作圆周运动, 则 α 粒子与质子的运动半径 比为: C
 - A. 1;
- B. 1/2;
- C. $\sqrt{2}$:
- D. $\frac{\sqrt{2}}{2}$

解析 本题考查带电粒子在电场、磁场中的运动。在加速电场中有

$$qU = \frac{1}{2}mv^2$$

在匀强磁场中有

 $qvB = m\frac{v^2}{R}$

得到

 $R = \sqrt{\frac{2mU}{aR^2}}$

所以

$$\frac{R_{\rm H}}{R_{\alpha}} = \sqrt{\frac{m_{\rm H}}{m_{\alpha}} \cdot \frac{q_{\alpha}}{q_{\rm H}}} = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

15. (2分) 真空中有两块相互平行的无限大均匀带同种电荷的薄平板,其中 密度为 σ ,另一块的电荷密度为 2σ ,则两平板间的电场强度大小为

A.
$$\frac{3\sigma}{2\varepsilon_0}$$
;

解析 对一块平板,使用高斯定理

$$2ES = \frac{Q}{\varepsilon_0}$$

$$E = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}$$

根据电场的叠加原理,两平板间的电场强度大小为 $\frac{\sigma}{2\epsilon_0}$

16. (2分) 如图6所示,一半径为R的圆形回路中通有电流 I_2 ,另一无限长直载流导线 AB 中通有电流 I_1 , AB 通过圆心, 且与圆形回路在同一平面内, 则圆形回路所受到 的来自 I_1 的磁场力大小是 CB. $F = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi R}$; C. $F = \mu_0 I_1 I_2$; D. $F = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2R}$

A.
$$F = 0$$
;

解析 考试来说, BC 量纲不对, 排除定性分析力显然不是零, 故选 C 当做大题来做:

如图 7所示

$$d\vec{F} = I_2 d\vec{l} \times \vec{B}$$

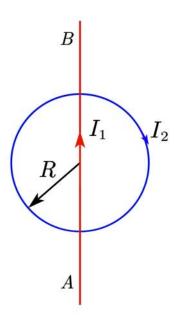


图 6 选择十六

由对称性 $F_v = 0$

$$dI = R d\theta$$

$$B_1 = \frac{\mu_0 I_1}{2\pi R \cos \theta}$$

$$dF = I_2 dI B_1 \sin 90^{\circ}$$

$$= I_2 R d\theta \frac{\mu_0 I_1}{2\pi R \cos \theta}$$

$$dF = I_2 R d\theta \frac{\mu_0 I_1}{2\pi R \cos \theta}$$

$$dF_x = dF \cos \theta$$

$$= I_2 R d\theta \frac{\mu_0 I_1}{2\pi R \cos \theta} \cos \theta$$

$$= I_2 R d\theta \frac{\mu_0 I_1}{2\pi R \cos \theta} \cos \theta$$

$$= \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi} d\theta$$

$$F = F_x$$

$$= \int dF_x$$

$$= \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi} \int_0^{2\pi} d\theta$$

$$= \mu_0 I_1 I_2$$

17. (2 分) 如图 8所示, 在磁感应强度为 B 的均匀磁场中, 有一圆形载流导线, a、b、c是其上三个长度相等的电流元,则它们所受安培力的大小关系为 B

$$A. \ F_a > F_b > F_c; \qquad B. \ F_b > F_c > F_a; \qquad C. \ F_a < F_b < F_c; \qquad D. \ F_a > F_c > F_b$$

$$C_{i}F < F_{i} < F$$
:

D.
$$F_a > F_c > F$$

解析 略

18. (2分) 如图 9所示, 一半径为 R 的导线圆环同一个径向对称的发散磁场处处正交, 环

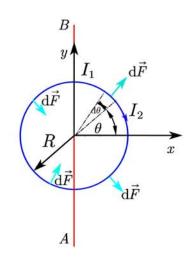


图 7 选择十六 2

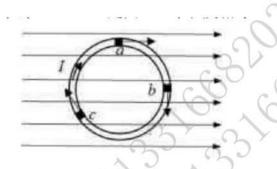


图 8 选择十七

上各个磁感应强度 \vec{B} 的大小相同, 方向都与环平面的法成 θ 角, 设导线圆环通有顺时针方向的电流 I, 则磁场作用在此环上的合力大小和方向是 A

A. $F = 2\pi RIB \sin \theta$ 垂直环面向上;

B. $F = 2\pi RIB$ 垂直环面向上;

C. $F = 2\pi RIB \sin \theta$ 垂直环面向下:

D. $F = 2\pi RIB\cos\theta$ 沿环面背向圆心

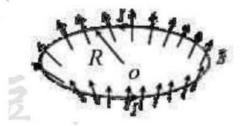


图 9 选择十八

解析 因 F = BIL 只适用于直导线的安培力的计算, 所以可以把导电圆环进行无限分割, 分割后的微元可以看作是直线. 将导线分成小的电流元, 任取一小段电流元为对象, 把磁场分解成水平方向和竖直方向两个分量, 则竖直方向的分磁场产生的安培力为零, 水平方向的分磁场产生的安培力为: $F = BIL = 2\pi BIR \sin \theta$, 方向为

竖直向上

19. (2 分) 如图 10所示,一根无限长的同轴电缆线,其芯线的截面半径为 R_1 ,相对磁导率为 μ_{r1} ,其中均匀地通过电流 I,在它的外面包有一半径为 R_2 的无限长同轴圆筒 (其厚度可忽略不计),筒上的电流与前者等值反向,在芯线与导体圆筒之间充满相对磁导率为 μ_{r2} 的均匀不导电磁介质。则磁感应强度 B 在 $R_1 < r < R_2$ 区中的分布为

C
A.
$$B = 0$$
; B. $B = \frac{\mu_0 \mu_{r1} I r}{2\pi R_1^2}$; C. $B = \frac{\mu_0 \mu_{r2} I}{2\pi r}$; D. $B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$

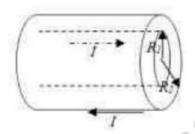


图 10 选择十九

解析 选择以中心轴为圆心, 半径为 r 的圆周为回路, 由磁介质中的安培环路定律可得

$$\oint_{L} \vec{H} \cdot d\vec{l} = I$$

$$H \cdot (2\pi r) = I$$

$$H = \frac{I}{2\pi r}$$

所以磁感应强度为

$$B = \mu_{r2}\mu_0 H = \frac{\mu_{r2}\mu_0 I}{2\pi r}$$

- 20. $(2 \, \beta)$ 关于均匀磁化磁介质中的磁感应强度 \vec{B} 和磁场强度 \vec{H} ,下列说法中错误的是
 - A. 无论抗磁质还是顺磁质, B 总是和 H 同方向;
 - B. 通过以闭合曲线 L 为边界的任意曲面的 B 通量均相等:
 - C. 若闭合曲线上各点的 H 均处处为 0,则该曲线所包围传导电流的代数和为 0;
 - D. 若闭合曲线内没有包围传导电流,则曲线上各点的 H 必处处为 0;

解析 :: |
$$\chi_m$$
 | $\ll 1$, $\mu_r = 1 + \chi_m > 0$, $B = \mu H$

所以无论抗磁质还是顺磁质, B 总是和 H 同方向;

如果闭合曲线内没有包围传导电流, 只能说明 \vec{H} 沿闭合曲线的环流为零, 并不能说明闭合曲线上各点的 \vec{H} 一定为零。

磁场中的高斯定理为

$$\oint_{S} \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0$$

由此可得,以闭合曲线 L 为边缘的任意曲面的 \vec{B} 通量均相等。

- 二、计算题 (一共5小题, 共60分, 每题12分)
 - 1. (12 分) 如图 11 所示, 三个平行金属板 A, B, C 面积均为 S, A, B 间相距 l_1, A, C 间相距 l_2 , 板与板之间充满介电常数为 ϵ 的均匀电介质, 忽略边缘效应, 如果使得 B, C 两板都接地, 并是 A 板带正电, 求:

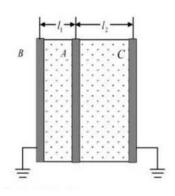


图 11 第二十一题

- (1) (10 分) B, C 板上的感应电荷大小是多少
- (2) (2 分) A, B 板间的电动势大小是多少
- (1) 由接地可知, 电容器外电场必处处为零, 即电位移矢量处处为零, 因此根据高斯定理

- 2. (12 分) 如图12所示, 已知: 内径为 R_1 , 外径为 R_2 的匀质空心薄圆环上均匀分布着总电荷量为 Q 的表面电荷。过盘心垂直于盘面的 X 轴上有一点 P,它与盘心 O 的距离为 L。请求出:
 - (1) (2 分) 半径为 $r(R_1 < r < R_2)$, 宽带为 dr 的细圆环的电荷量是多少?
 - (2) (4 分) P 处的电势 V_p 是多少?
 - (3) (6 分) P 点处的电场场强 E_P 是多少

提示
$$\int \frac{x}{\sqrt{x^2 + a^2}} dx = \sqrt{x^2 + a^2} + C$$
$$(uv)' = u'v + v'u$$
$$(\ln x)' = \frac{1}{x}$$

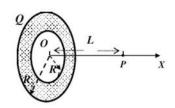


图 12 第二十二题

(1) 如图12取坐标 OX 过盘心垂直于盘面,原点 O ,在盘面取一距圆心为 r ,宽度

为 dr 的圆环带, 易知圆环带 ds =
$$2\pi r$$
dr,其上带电量为:
$$dq = \sigma ds = \frac{Q}{\pi (R_2^2 - R_1^2)} ds = \frac{2Qr dr}{R_2^2 - R_1^2} \quad \cdots \quad \star$$
 步骤 2 分,累计 2 分

 $\mathrm{d}V = \frac{\mathrm{d}q}{4\pi\epsilon_0 t} = \frac{\mathrm{d}q}{4\pi\epsilon_0 \sqrt{L^2 + r^2}} = \frac{\mathrm{ent}(3)}{2\pi\epsilon_0 (R_2^2 - R_1^2)\sqrt{L^2 + r^2}} \cdots 本步骤 2 分,累计 4 分$ 所以整个带电圆盘在 P 点产生的电势为 (2)

$$E(x) = -\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}x} = -\frac{Q}{2\pi\epsilon_0 R^2} \left(\frac{1}{2} \frac{2x}{\sqrt{x^2 + R_2^2}} - \frac{1}{2} \frac{2x}{\sqrt{x^2 + R_1^2}} \right) =$$

$$E_{P} = \frac{QL}{2\pi\epsilon_{0}R^{2}} \left(\frac{1}{\sqrt{L^{2} + R_{1}^{2}}} - \frac{1}{\sqrt{L^{2} + R_{2}^{2}}} \right) \quad \cdots \quad \Rightarrow \text{$\pm \% \ 2 \ \beta, \ \text{$\%$ it } 12 \ \beta}$$

- 3. (12 分) 如图13所示, 已知 A, B 为同心放置的两个薄导体球壳 (球壳厚度忽略), 其 半径分别为a, 4a, 两球壳之间充满两层不同的均匀电介质 1 和 2, 它们的厚度为 a, 2a, 绝对介电常数分别为 ϵ_1 和 ϵ_2 , A, B 之间接上一个电源, 使得 A 球壳上带有 电量 +Q。则:
 - (1) (6 分) 请求出 r = 3a 处介质面上的电场强度 \vec{E} 和电位移矢量 \vec{D} 的大小。
 - (2) (4 分) 请给出 AB 球壳面之间的电势 U_{AB} 大小是多少?
 - (3) (2 分) 请计算出两个导体球壳 AB 间的电容 C_{AB} 大小是多少
 - 作一个闭合面包围 r = a 出的介质面,则有介质的高斯定理知道: (1)

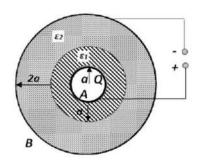


图 13 第二十三题.jpg

$$\begin{split} U_A &= \int_a^{4a} \vec{E} \cdot d\vec{l} \\ &= \int_a^{2a} \frac{Q dr}{4\pi \epsilon_1 r^2} + \int_{2a}^{4a} \frac{Q dr}{4\pi \epsilon_2 r^2} \\ &= \frac{Q}{4\pi} \left[\frac{1}{\epsilon_1} \left(\frac{1}{a} - \frac{1}{2a} \right) + \frac{1}{\epsilon_2} \left(\frac{1}{2a} - \frac{1}{4a} \right) \right] \\ &= \frac{Q(2\epsilon_2 + \epsilon_1)}{16\pi a \epsilon_1 \epsilon_2} \end{split}$$

球形电容器的电容量 C_{AB} 为 $C_{AB} = \frac{Q}{U_{AB}} = \frac{Q \times 16\pi\epsilon_1\epsilon_2 a}{Q(2\epsilon_2 + \epsilon_1)} = \frac{16\pi\epsilon_1\epsilon_2 a}{(2\epsilon_2 + \epsilon_1)} \quad \cdots \quad \text{本步骤 2 分, 累计 12 分}$

4. (12 分) 如图 14 所示,强度为 I 的电流均匀的流过半径为 R 的圆柱形长直导线,已知该导线中充满了相对磁导率为 μ_r 的均匀磁介质,试计算长度为 I 的导线内的磁场通过图中所示的剖面 (以半径 R 为一边, L 为另一边的矩形剖面)的磁通量大小

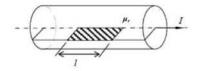


图 14 第二十四题

答案
$$\phi = \frac{\mu_0 \mu_r II}{4\pi}$$
解析

- 5. (12 分) 如图 15所示,一条有着微小截面 (截面积为 S) 的匀质细线整体均匀带有正电,其中电荷线密度为 $\lambda(\lambda>0)$,将该细线放入一个半径为 R 的圆形导轨中,其刚好为圆环导轨周长的一半。使得该细线绕导轨圆心 O 以角速度 ω 在导轨内做逆时针方向匀速圆周运动,已知该细线的截面半径与圆周半径 R 相比可以忽略,且圆环导轨所在圆平面上有一过圆心 O 的垂直向上的中轴线 X ,其上有一点 P 与圆环平面的距离为 L ,求:
 - (1) (4分) 此带电细线作圆周运动所产生的电流密度 j 的大小?
 - (2) (4 分) 圆心 O 点处的磁感应强度 B_0 的大小和方向?
 - (3) $(4 \, \beta)$ 中轴线 $X \perp P$ 距离圆环平面的距离为 L ,则该点的磁感性强度 B_P 的大小以及方向?

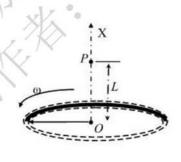


图 15 第二十五题

(1) 解析

(2) 解析

因为带电圆环旋转后形成圆电流,可知圆环的电流 $I = \frac{\lambda \omega R}{2}$ 环电流在轴线上 O 点产生的磁感应强度计算公式,参照圆环中电流与 O 点的

关系,根据毕奥萨伐尔定律

$$dB_o = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I d\vec{l} \times \vec{e_r}}{r^2} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{\lambda \omega R dl}{2R^2}$$

 $\begin{aligned} \mathrm{d}B_o &= \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I \, \mathrm{d}\vec{l} \times \vec{e_r}}{r^2} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{\lambda \omega R \, \mathrm{d}l}{2R^2} \\ \mathrm{由右手螺旋法则可知,} &\quad \text{其方向均为垂直圆环平面向上} \quad \dots \dots \text{本步骤 2 分, 累计 6 分} \end{aligned}$

所以
$$B_o = \int_I dB_o = \frac{\mu_0}{8\pi} \frac{\lambda \omega R}{R^2} 2\pi R = \frac{\mu_0 \lambda \omega}{4}$$

方向为垂直圆环平面向上(沿 X 正方向) ·····

(3) 解析

根据 (2) 中的计算以及对 X 轴上 P 点与环上任意一电流源所产生的磁感应强 度的三角关系, 根据毕奥萨伐尔定律以及矢量叠加原理, P 点处磁感应强度在 X 轴线上的投影为:

$$dB_{P} = \frac{\mu_{0}}{4\pi} \frac{I d\vec{l} \times \vec{e}_{r}}{r^{2}} \cos \theta = \frac{\mu_{0}}{4\pi} \frac{\lambda \omega R dl}{2(R^{2} + L^{2})} \frac{R}{\sqrt{R^{2} + L^{2}}} \cdots \wedge \hat{A} \mathcal{B} \Re 2 \mathcal{B}, \, \Re \mathcal{H} 10 \, \mathcal{B}$$

所以 $B_P = \int_I dB_X = \frac{\mu_0}{8\pi} \frac{\lambda \omega R \cdot R}{(R^2 + L^2)^{\frac{3}{2}}} 2\pi R = \frac{\mu_0 \lambda \omega R^3}{4(R^2 + x^2)^{\frac{3}{2}}}$ 其方向为垂直圆环平面向上(沿 X 轴线正方向)